2012/11/8 B4 市川 竜嗣

Single-cycle terahertz pulses with amplitudes exceeding 1 MV/cm generated by optical rectification in LiNbO3 「LiNbO3結晶での光整流による1MV/cmを超えるシングルサイクルテラヘルツパルス」 H.Hirori, A.Doi, F.Blanchard, and K.Tanaka APPLIED PHYSICS LETTERS **98**, 091106 (2011)

Abstract :

In this paper, they generate single-cycle terahertz (THz) pulse using the tilted-pump-pulse-front scheme with LiNbO₃. In generation setup, the condition that the image of the grating coincides with the tilted-optical-pulse-front is fulfilled to obtain optimal THz beam characteristics and pump-to-THz conversion efficiency. By using an uncooled micro bolometer-array THz camera, it is found that the THz beam leaving the output face of the LN crystal can be regarded as a collimated rather than point source. The designed focusing geometry enables tight focus of the collimated THz beam with a spot size close to the diffraction limit, and the maximum THz electric field of 1.2 MV/cm is obtained.

高強度テラヘルツパルス発生による最近の成果として、大規模なオブジェクトのイメー ジング、医療診断や治療、そしてセキュリティ問題に対するリモートセンシング技術のよ うな多くの有望なアプリケーションを作成した。さらに、高強度テラヘルツパルスは量子 状態のコヒーレントテラヘルツ操作、高次高調波発生、非線形光学現象、および固体中の 非線形移動現象のような未開発非線形現象の研究が可能にする。

Heblingらが2002年に、LiNbO3(LN)結晶による、位相整合を満たし効率的なテラヘル ツパルス発生が行えるパルス面傾斜法を提案し、その技術は急速に発展した。この手法に より、低繰り返し周波数の増幅チタンサファイア(Ti:S)レーザーを用いて数10Jのエネルギー を持つテラヘルツパルス発生の可能性を実証した。アプリケーションの汎用性と未開発で ある非線形現象の研究を可能にするためには、最適なテラヘルツビーム特性と最大化した テラヘルツの電界強度を得るためのセットアップが必要である。最近の詳細な調査により、 回折格子とレンズから成るセットアップにおけるイメージングエラーが、LN 結晶の出力面 後において、テラヘルツパルスの強度の歪みにつながることが予測された。この歪みによ って、テラヘルツ計測の最適な設計において不正確さの原因となる強度と不明な発散が生 じ、その結果、アプリケーションを制限してしまう。

本稿では、1.3モル%のMgOを添加したLN 結晶を用い、パルス面傾斜法によるシングル サイクルテラヘルツパルスの発生について述べる。テラヘルツパルス発生のセットアップ において、回折格子のイメージが傾斜波面と一致する条件は、最適なテラヘルツビーム特 性と励起光—テラヘルツ変換効率を得るために満たされる。LN 結晶の出力面から出るテラ ヘルツパルスの伝搬特性は、非冷却マイクロボロメータアレイのテラヘルツカメラで測定 した。その結果、テラヘルツパルスは1テラヘルツで水平方向に52±5ミリラジアンの発散が あることがわかった。コリメートしたテラヘルツビーム用に設計した焦点の配置は、1テラ ヘルツあたり約300μmのスポットサイズで電気光学結晶(EO結晶)に厳密な集光を可能に し、1.2 MV / cmのピーク電界強度と1×10⁻³のエネルギー変換効率が得られた。



図1 (a) パルス面傾斜法を用いたテラヘルツパルス発生の概略図(b) EOサンプリングの概 略図

図1aと1bにそれぞれ、パルス面傾斜法とEOサンプリングを用いたテラヘルツパルス発生 セットアップの概略図を示す。励起光源には、パルスエネルギー4 MJ、半値幅85 fs、中心 波長780 nm、繰り返し周波数1 kHzの増幅Ti:Sレーザーを用いた。EOサンプリングには増幅 したパルスに同期した80MHzの繰り返し周波数を持つオシレータからの光パルスを用いた。 効率的にテラヘルツパルスを発生させるために、LN 結晶内で励起光の群速度とテラヘルツ パルスの位相速度を一致させる、すなわち $v_p^{gr}\cos\gamma = v_{THz}$.となる。図1に示すように、回 折格子と2つのシリンドリカルレンズを用いて波面を傾斜させている。波面の傾斜角γは次 式で表される。

$$\tan \gamma = \frac{m\lambda_0 p}{n_p^{gr}\beta_1 cos\theta_d}$$

m、 θ_d 、pはそれぞれ回折次数、回折角、回折格子の溝密度であり、また、 λ_0 、 n_p^{gr} はそれ ぞれ中心波長、中心波長に対するLN 結晶内での群屈折率である。 β_1 は、レンズの水平方向 の倍率である。テラヘルツパルスはLN 結晶の出力面に対して垂直に出ていくため、図1a に示すLN 結晶の角度は γ と等しくしなければならない。

最適なテラヘルツビーム特性と励起光―テラヘルツ変換効率を得るためには、回折格子のイメージを持つ励起光のパルス幅は極小であるため、LN 結晶内部における回折格子のイメージの傾斜角は励起光パルス前面と一致させなければならない。傾斜角0は次式で表せる。

 $\tan\theta = n\beta_2 tan\theta_d$

ここで、n はLN 結晶の励起光に対する屈折率、 β_2 は回折格子のもつイメージ面の水平方向の倍率である。



図2 水平方向の倍率β1および回折格子の像に対するレンズの水平方向の倍率である。

図2は、回折角 θ_d に対する溝数が異なる場合の β_1 、および β_2 の値を計算して得られた曲線 であり、 β_1 、 β_2 が同じ値であるとき、角度整合の条件が満たされている。今回は、1テラへ ルツ付近の発生を高効率化するため、 $\theta \ge \gamma を 62^\circ$ に設定している。図2に示すように、 溝数1800cm⁻¹に対する β_1 (実線)と β_2 (破線)の曲線は、 θ_d =55.7°のとき0.59で同じ値と なっている。実際のセットアップでは、図1aに示すように4f光学系によって、計算した値0.59 とほぼ同じ値である0.6に設定されている。



図3(a) テラヘルツ強度のイメージ (b) LN 結晶の出力面から45mmでの断面図 (c) テラ ヘルツ伝搬距離に対するスポットサイズ

図3aと3bにそれぞれ、LN 結晶の出力面から45mmの位置でのテラヘルツ強度イメージと 断面プロファイルを示す。1テラヘルツ用300GHz幅のバンドパスフィルタ(村田製作所、品 番MMBPF40-1000)を通過したテラヘルツ強度イメージを240×320ピクセルの非冷却マイ クロボロメータテラヘルツカメラ(NEC社、品番IRVT0830)で測定した。図3bにおいて、 実線は対応するガウス曲線を示し、垂直方向と水平方向の半値幅での直径は、それぞれ1.9 ミリメートルと1.3ミリメートルである。画像が縦に細長くなっているのは、半値幅におけ る入射励起光のスポット径5.2mmが水平方向に0.6倍になっており、残留イメージングエラ ーとLN 結晶におけるテラヘルツ吸収があるためである。

図3cに、テラヘルツパルスの伝搬距離に対する、スポットサイズの変化を示す。テラヘル ツビームは水平方向と垂直方向にそれぞれ、54±5mrad、-5±5mrad 発散がある。図3bと3cに 示している半径方向に対称なガウスビームを持つコリメータビームは、テラヘルツ発生の 4f光学系が回折格子のイメージの角度と励起光のパルス前面を一致させることができたこ とを示している。最大化したテラヘルツパルスの電界強度を取得するには、テラヘルツカ メラの測定により確認したコリメータテラヘルツパルスの、エキスパンド、コリメート、 集光を厳密にしないといけない。図1bに示すように、点光源ではなくコリメータテラヘル ツビーム源を仮定して、3つの軸外し放物面鏡PM1、PM2、PM3によってEO結晶に対し焦点 を配置した。



図4 (a) テラヘルツパルスの時間波形 (b) スペクトル波形 (c) 軸外し放物面鏡PM3の 焦点位置でのテラヘルツイメージ (d) テラヘルツイメージの断面図

図4aと4bに、厚さ300µmのGaP 結晶によるEOサンプリングによって得た、テラヘルツパルスの時間波形とフーリエ変換によって得られたスペクトル波形をそれぞれ示す。テラヘルツパルスのピーク電界強度において、バランス検出器によって測定した信号I_{A、}I_Bの最大変調、すなわち(I_A-I_B)/(I_A+I_B)の値はシリコン減衰器を用い0.44であり、この値は、シリコン減衰器なしでの1.2 MV / cmの電界に対応している。図4bに示すスペクトルには、1テラヘルツ周辺の最大強度と、乾燥空気パージをしていないため、水蒸気による吸収線がある。

図4cと4dに、軸はずし放物面鏡(図1bのPM3)の焦点距離の位置での、テラヘルツイメ ージと強度プロファイルをそれぞれ示す。図4dの強度プロファイルにおいて、垂直方向と 水平方向の半値幅におけるテラヘルツパルスのスポット径は両方それぞれ約300µmである。 回折限界に近い小さなスポットサイズは、図1bに示す焦点の配置が、十分にテラヘルツパ ルスが焦光していることを意味している。時間的・空間的にテラヘルツ強度を統合すること により、総パルスエネルギーはおよそ2µJ、エネルギー変換効率はおよそ1×10⁻³に達すると 推定される。また、焦電検出器によって得られたテラヘルツパルスエネルギーは3µJにまで 達している。

結論として、LN 結晶とパルス面傾斜法を使用して、シングルサイクルテラヘルツパルス を生成した。パルス面の厳密な制御により、最適な励起光―テラヘルツ変換効率およびテ ラヘルツパルスのビーム特性を改善した。LN 結晶の出力面から出るテラヘルツビームの空 間的形状と発散は、テラヘルツカメラによって観測され、テラヘルツビームは点光源では なくむしろコリメータビームとみなすことができることがわかった。コリメートしたテラ ヘルツビーム源の発生を仮定して設計した焦点の配置により、約300µmのスポットサイズに テラヘルツビームを厳密に集光でき、1.2MV/cmのピーク電界強度と、エネルギー変換効率 1×10⁻³が得られた。